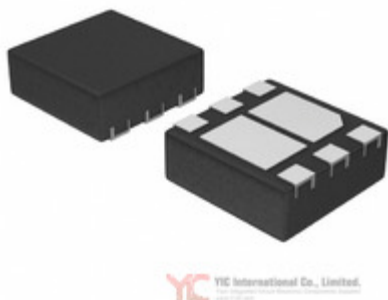

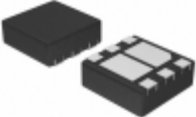
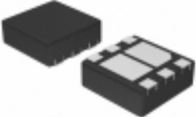
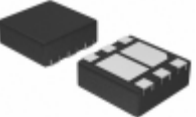

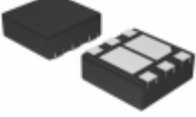
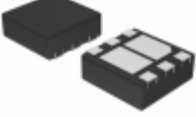
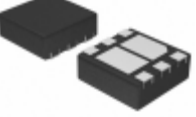
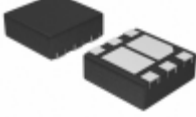
	<h2 style="color: red;">NTLJD3182FZTBG</h2>
 <p style="font-size: small;">Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: NTLJD3182FZTBG
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 2.2A 6-WDFN
	Datenblätter:  NTLJD3182FZTBG.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	NTLJD3182FZTBG
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 2.2A 6-WDFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	6-WDFN (2x2)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	100 mOhm @ 2A, 4.5V
Verlustleistung (max)	710mW (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	6-WDFN Exposed Pad
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	450pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7.8nC @ 4.5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Isolated)
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.2A (Ta)

NTLJD3182FZTBG Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NTLJD3182FZTBG-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NTLJD3182FZTBG AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ NTLJD3182FZTBG E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NTLJD3182FZTAG ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 2.2A 6-WDFN</p>	 <p>NTLJD3181PZTBG ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 20V 2.2A 6WDFN</p>	 <p>NTLJD4150PTBG ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 30V 1.8A 6WDFN</p>	 <p>NTLJF3117PRT1G ON NTLJF3117PRT1G ON</p>
 <p>NTLJD3181PZTAG ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 20V 2.2A 6WDFN</p>	 <p>NTLJD3119CTAG ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 20V 6WDFN</p>	 <p>NTLJD3183CZTAG ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 20V 6WDFN</p>	 <p>NTLJD3119CTBG ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 20V 6WDFN</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

- | | | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|---|
| NTLJD3182FZTBG AMI Semiconductor / ON Semiconductor | NTLJD3182FZTBG Datenblatt | NTLJD3182FZTBG-Datenblätter | NTLJD3182FZTBG PDF | AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTLJD3182FZTBG |
| NTLJD3182FZTBG Electronic | NTLJD3182FZTBG-Komponenten | NTLJD3182FZTBG-Verteiler | NTLJD3182FZTBG-Bild | NTLJD3182FZTBG-Teil |
| NTLJD3182FZTBG Preis | NTLJD3182FZTBG Hersteller | NTLJD3182FZTBG Bild | NTLJD3182FZTBG Aktie | NTLJD3182FZTBG Inventar |
| NTLJD3182FZTBG Neu | NTLJD3182FZTBG Original | NTLJD3182FZTBG garantiert | NTLJD3182FZTBG RFQ | NTLJD3182FZTBG Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited